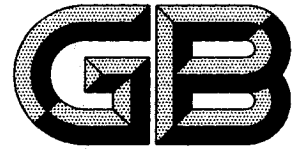


ICS 31.200
L 55



中华人民共和国国家标准

GB/T 15877—1995

蚀刻型双列封装引线框架规范

Specification of DIP leadframes produced by etching

1995-12-22 发布

1996-08-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

蚀刻型双列封装引线框架规范

GB/T 15877—1995

Specification of DIP leadframes produced by etching

1 主题内容与适用范围

1.1 主题内容

本规范规定了半导体集成电路蚀刻型双列封装引线框架(以下简称引线框架)的技术要求及检验规则。

1.2 适用范围

本规范适用于半导体集成电路塑料双列封装引线框架,其他封装形式引线框架也可参照使用。

2 引用标准

GB 7092—93 半导体集成电路外形尺寸

GB/T 14112—93 半导体集成电路塑料双列封装冲制型引线框架规范

GB/T 14113—93 半导体集成电路封装术语

SJ/Z 9007—87 计数检查抽样方案和程序

3 术语、符号、代号

本规范所用术语、符号和代号应按 GB/T 14113 的规定。

4 技术要求

4.1 设计

引线框架的外形尺寸应符合 GB 7092 的有关规定,并符合引线框架设计的要求。

4.1.1 引线键合区的最小面积

引线键合区应保证其宽度不小于 0.2mm,长度不小于 0.635mm,由于蚀刻工艺中的钻蚀是难以避免的,并将产生端头倒圆现象,因此在长度计量时应从距端部 0.25mm 处起进行计算。

4.1.2 金属间的间隔

引线框架各内引线之间,内引线与芯片粘接区之间的距离不小于 0.15mm。

4.2 引线框架形状和位置公差

4.2.1 引线框架的侧弯应小于标称条长的 0.5%。

4.2.2 引线框架的卷曲应小于标称条长的 0.3%。

4.2.3 引线框架的横弯

引线框架的最大横弯尺寸应符合表 1 的规定。